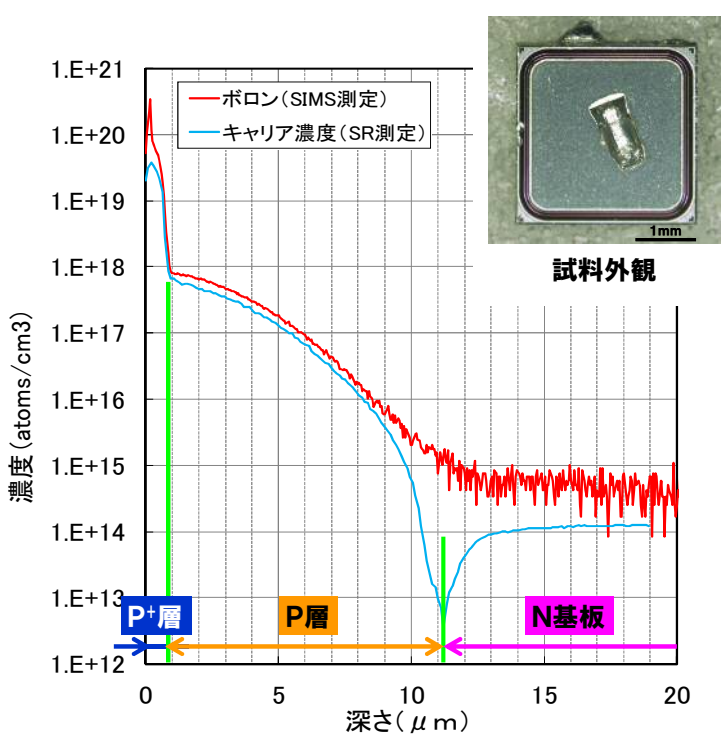


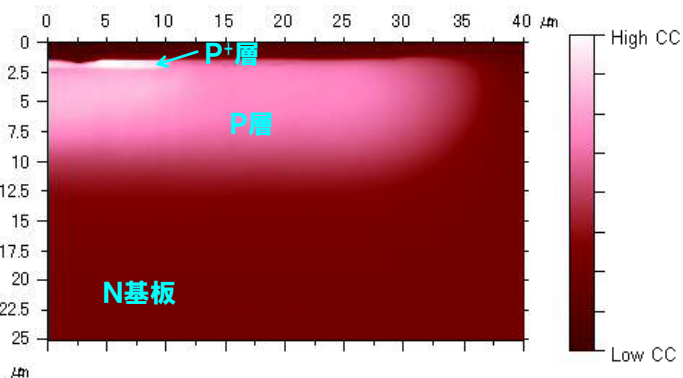
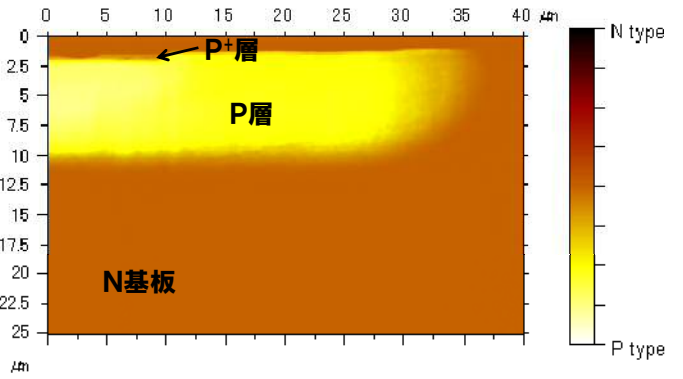
種々の手法における拡散層評価技術

目的・用途に応じた拡散層の評価が実施できます！

Diodeの拡散層評価



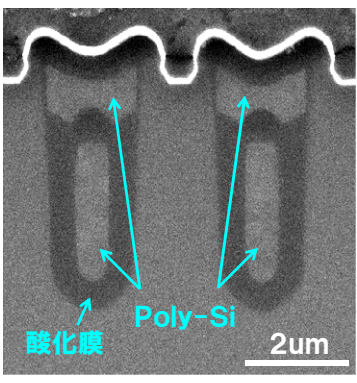
アノード部のSIMSおよびSRプロファイル



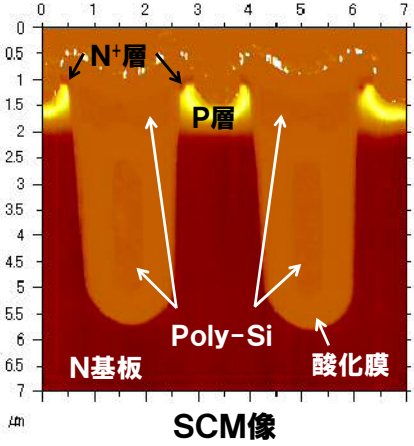
アノード終端部のSCM像(上) / SMM像(下)

SIMS測定よりドーパントプロファイルを、SR測定よりキャリア濃度プロファイルを得ることができます。デバイスの微小領域(数~数十μm)においては、SCM/SMM観察にて拡散層を評価できます。
⇒ 試料・目的に応じた拡散層評価が可能です！

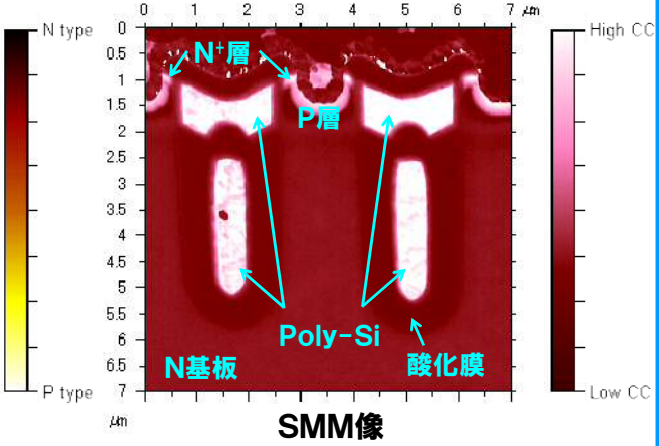
トレンチゲートMOSFET断面のSCM/SMM観察



SEM像



SCM像



SMM像

SCM観察よりPN極性情報を、SMM観察よりキャリア濃度情報を含む拡散層評価ができます。
⇒ SCMとSMMを組合せることで、構造をより明確に観察できます！